

# (Ca<sub>x</sub>Sr<sub>1-x</sub>)Si<sub>5</sub>N<sub>8</sub>:Eu<sup>2+</sup> нунтаг материал гарган авах болон түүний гэрлийн цацаргалтын судалгаа

С.Баасанжав<sup>1</sup>, Цогхүү<sup>2</sup>, Н.Төвжаргал<sup>1\*</sup>, Ж.Даваасамбуу<sup>1</sup>, О.Төгс<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Монгол улс, Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улсын Их Сургууль,

Шинэжүх ухааны сургуулийн Физикийн тэнхим

<sup>2</sup>БНХАУ, Хөх хот, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн

Функционал материалын физик, химийн төв лаборатори

Энэ ажлаар улаан гэрэл цацууллагч (Ca<sub>x</sub>Sr<sub>1-x</sub>)Si<sub>5</sub>N<sub>8</sub>:Eu<sup>2+</sup> нунтаг материалыг тодорхой молийн харьцаа бүхий Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Sr<sub>3</sub>N<sub>2</sub>, Ca<sub>3</sub>N<sub>2</sub> нитридууд болон EuB<sub>6</sub> дээж ашиглан хатуу төлөвийн урвалын аргаар Ca болон Sr-ийн янз бурийн концентрацтай гарган авав. Рентген дифракцын хэмжилтийн үр дүнгээс үзэхэд  $x = 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.59, 0.5, 0.4$  тохиолдлуудад цэвэршил өндөртэй дээжүүд амжилттай гаргаж авсан болох нь харагдаж байна. (Ca<sub>x</sub>Sr<sub>1-x</sub>)Si<sub>5</sub>N<sub>8</sub>:Eu<sup>2+</sup> дээж нь улаан гэрлийн цацаргалт хийх бөгөөд  $x$ -ийн хэмжээнээс хамааран улаан гэрлийн долгионы урт 580 нм-ээс 620 нм хооронд өөрчлөгдөж улаан шилжилт хийж байгааг үзүүлэв.

PACS numbers: 42.72.-g, 85.60.Jb, 42.25.Bs

## I. Удиртгал

Хатуу төлөвийн гэрэлтүүлгийн технологид гэрэл цацууллагч(люминисцент) материалуудыг ашиглаж эхэлсэн нь үсрэнгүй хөгжлийн үндэс болсон. Үүнтэй холбоотойгоор гэрэлтүүлэг, дэлгэцийн технологид зориулсан цагаан гэрэл цацаргагч диод(wLED)-ын хөгжилд гэрэлтэгч нитрид материалууд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Нитрид материалуудын бүтэц, найрлагыг өөрчлөх замаар түүний гэрэл цацууллагч шинж чанарыг хувиргалтын өндөр үр ашигтай, бага дулааны эфекттэй байхаар удирдан тохируулж болдог. Иймээс судлаачид шинэ гэрэл цацууллагч нитрид материал гарган авах болон тэдний гэрэл цацууллагч шинж чанарыг сайжруулах, хатуу төлөвийн гэрэлтүүлэг(LED, лазер г.м)-ийн янз бурийн хэрэглээнд зориулсан судалгааг суулийн жилүүдэд маш эрчимтэй хийж байна[1-4].

Өндөр гэрэл цацууллагч чанар бүхий хатуу төлөвийн лазер гэрэлтүүлгийн технологид керамик материал шинэ боломжуудыг бий болгож байна[5]. Лазер диод(LD) нь гэрэл цацууллагч диод(LED)-тай харьцуулахад өндөр чадал бүхий лазераар гэрэлтүүлж, гаралтад өндөр эрчих бүхий гэрэл цацуулдгаараа онцгой байдаг. Лазер гэрэлтүүлгийн технологид, лазер диодоор үүсгэсэн цэнхэр өнгийн лазерын царагийг өөр гэрэлтэгч материал дээр нарийн фокуслан тусгахад тэндээс өндөр эрчимтэй лазерын гэрэл цацаргах тул энд уламжлалт гэрэл цацууллагч диодын технологид ашиглагдаг полимерт гэрэл цацууллагч суулгах аргыг ашиглах боломжгүй юм. Иймээс лазерын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг дулааны эфектгүй ашиглах шинэлэг материал хэрэгтэй болдог. Шилэнд гэрэл цацууллагч суулгах арга нь

шилэн хэв материалд гэрэл үүсгэгч нунтгийг тодорхой хэмжээний тархалттай суулгах арга шинэ тутам хөгжиж байна[6]. Органик полимертэй харьцуулахад шилний дулаан дамжуулалт болон дулааны эсэргүүцэл илүү байдаг[7].

Мөн дулааны эфект, квант үр ашиг зэрэг люминисцентийн шинж чанарын сайжруулалт хийснээр гэрэл цацууллагч керамик материалууд шилэнд гэрэл цацууллагч суулгах технологиос олон давуу талуудтай болох ба ийм керамик материалуудын нэг бол CaAlSiN<sub>3</sub>:Eu<sup>2+</sup> нитрид юм[8]. Энэ төрлийн материалыг гарган авах, гэрлийн цацаргалтыг судлах ажлыг өмнө бид гүйцэтгэж байсан[9].

Янз бурийн гэрэл цацууллагч нитрид материалыг гарган авахдаа нитрид нэгдлүүд(AlN<sub>4</sub>, SiN<sub>4</sub>, MgN<sub>4</sub>, LiN<sub>4</sub>, GaN<sub>4</sub>, GeN<sub>4</sub>, CN<sub>4</sub>, PN<sub>4</sub> г.м)-ийг агуулсан бүтцүүдийг ихэвчлэн ашигладаг. Иймээс эдгээрийг маш олон янзын комбинацаар гарган авах туршилтуудыг гүйцэтгэх боломжтой.

Түүнчлэн, гэрэл цацууллагч материалын нийтийн бурийн люминисцентийн төвүүдтэй байж болох бөгөөд тэдгээрийг гэрэл цацууллагч нитрид материалуудыг Eu<sup>2+</sup> хольцот, Ce<sup>3+</sup> хольцот, идэвхжүүлэгчийг болон бусад идэвхжүүлэгчээр чанаржуулсан гэж ангиж болно[10]. Eu<sup>2+</sup> нь гэрэл цацууллагч материалын идэвхжүүлэгчээр хамгийн өргөн ашиглагддаг элементийн нэг бөгөөд энэ түүний тэгш-зөвшөөрөгдсөн 4f<sup>7</sup> ↔ 4f<sup>6</sup>5d<sup>1</sup> төлөвүүдийн электроны шилжилт, өндөр хэлбэлзлийн хүч( $10^{-2}$ )-тэй холбоотой үүсэх эрчим ихтэй, өргөн фотолюминисцентийн спектртэй холбоотой. Eu<sup>2+</sup> ионы 5d төлөвийн электронууд нь бүрэн дүүрээгүй байдаг тул энергийн төвшнүүд нь сууж буй орчны байдлаас хүчтэй хамаардаг. Тиймээс Eu<sup>2+</sup>-ийн гэрлийн цацаргалтыг хэт ягаан, хөх, ногоон, шар, улаан хүртэл маш өргөн мушкид өөрчилж болно[11].

Eu<sup>2+</sup>-аар идэвхжүүлсэн M<sub>2</sub>Si<sub>5</sub>N<sub>8</sub> (M=Ca, Sr, Ba) материал нь маш өргөн өдөөлтийн бүстэй,

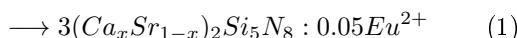
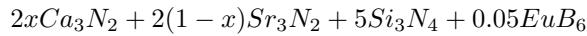
\*E-mail: tuvjargal@num.edu.mn

гэрлийн цацаргалтыг нь тохируулж удирдах боломжтой, өндөр квант үр ашигтай зэрэг олон сайн шинж чанартай чухал улаан гэрэл цацруулагч материал болох нь тогтоогдоод байна[12–16].

Иймээс энэ ажлаар улаан гэрэл цацруулагч ( $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$  материалыг тодорхой молийн харьцаа бүхий  $Si_3N_4$ ,  $EuB_6$ ,  $Sr_3N_2$  болон  $Ca_3N_2$  нитридуудийг ашиглан хатуу төлөвийн урвалын аргаар Са болон Sr-ийн янз бүрийн концентрацтай гарган авч, түүний гэрлийн цацаргалт Са болон Sr-ийн хэмжээнээс хамааран хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах зорилготой.

## II. Туршилт

( $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$ -ийг гарган авахдаа хатуу төлөвийн урвалын аргаар тодорхой молийн харьцаа бүхий  $Si_3N_4$ ,  $EuB_6$ ,  $Sr_3N_2$  болон  $Ca_3N_2$  нитридуудийг ашиглан тэгш.(1)-д үзүүлсэн урвалын тэгшитгэлийн дагуу гарган авна.



Ингэхдээ  $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$  - ийг Са болон Sr-ийн хэмжээ  $x$ -ээс хамааруулан гарган авахад шаардагдах нитридуудийн хэмжээг тэгш.1-ийн дагуу тооцсоныг хүснэгт.I-д үзүүлэв.

**Хүснэгт I:** Янз бүрийн  $x$  агуулга бүхий ( $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$ -ийг гарган авах нитридуудийн хэмжээ

№	$Ca_3Na_2$ (г)	$Sr_3Na_2$ (г)	$Si_3Na_2$ (г)	$EB_6$ (г)	$x$
1	3.00	0.0	5.67	0.331	1.0
2	2.28	0.5	4.79	0.280	0.9
3	2.02	1.0	4.79	0.280	0.8
4	1.77	1.5	4.79	0.280	0.7
5	1.45	2.0	4.79	0.280	0.6
6	1.26	2.5	4.79	0.280	0.5
7	1.01	3.0	4.79	0.280	0.4
8	0.00	3.5	2.87	0.168	0.0

$Sr_3N_2$ ,  $Ca_3N_2$  нэгдлүүд нь агаарт амархан исэлддэг материал тул тодорхой молийн харьцааар бэлтгэсэн дээжүүдийг исэлдлээс хамгаалж Glove box-т нэгэн төрөл болтол нунтаглаж хольж өгөх бөгөөд ингэхдээ урвалжид шаардагдах бүх зүйлсийг Glove box-ийн дамжуулах хоолойн хэсэгт  $N_2$ -оор гурван удаа угааж ариутгана. Нэгэн төрөл болтол хольж бэлтгэсэн дээжүүдээ өндөр цэвэршилтэй  $N_2$  орчин бүхий шатаах зууханд дараах горимын дагуу шатааж бэлтгэнэ. Үүнд:

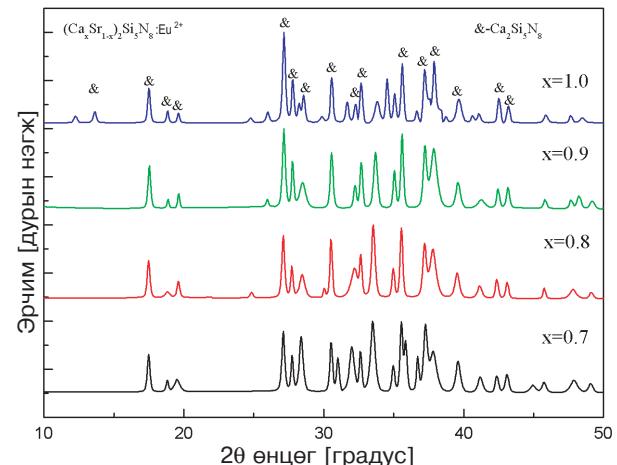
- $0^\circ C$ -ээс  $\sim 800^\circ C$  хүртэл нэг цаг халаана
- $\sim 800^\circ C$  температурт 30 минут шатаана
- $800^\circ C$ -ээс  $\sim 1550^\circ C$  хүртэл 80 минут халаана
- $\sim 1550^\circ C$  температурт 4 цаг шатаана
- Эцэст нь тасалгааны температур хүртэл аажим хөргөнө.

Энэ шатлан шатаах процесс нь урвалын горимыг тохируулах зорилготой хатуу төлөвийн урвал явуулахад түгээмэл хэрэглэдэг арга юм.

Дээжийн цэвэршилт болон кристалжилтыг талгааны температурт Си анод бүхий Shimatzu MAXima X XRD7000 нунтаг дээжийн рентген дифрактометр, гэрлийн цацаргалтыг дээжийг тодорхой долгионы урт бүхий гэрлээр өдөөж HITACHI F-4600 спектрофотометр ашиглан хэмжинэ.

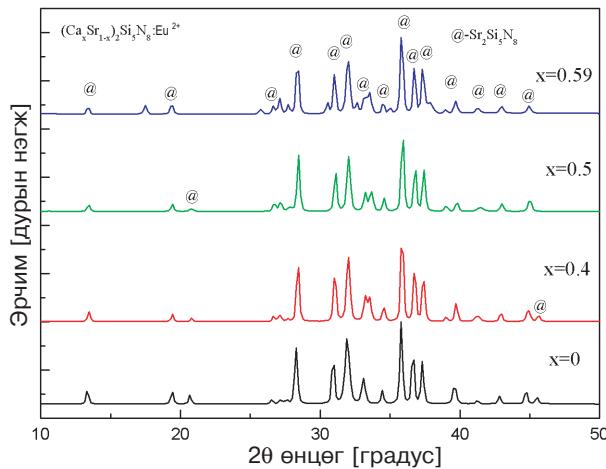
## III. Үр дүн

( $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$  ( $x=0, 0.4, 0.5, 0.59, 0.7, 0.8, 0.9, 1$ ) нунтаг дээжүүдийн цэвэршилт болон кристалжилтыг шалгасан рентген дифракцын хэмжилтийн үр дүнг зураг 1, 2-т үзүүлэв. Зураг.1-д &-ээр тэмдэглэсэн пикууд нь  $Sr_2Si_5N_8$  бол зураг.2-т @-ээр тэмдэглэсэн пикууд нь  $Ca_2Si_5N_8$  болно.



Зураг 1: ( $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$  ( $x=1.0, 0.9, 0.8, 0.7$ ) дээжүүдийн рентген дифракцын спектр, энд &-өөр тэмдэглэсэн пикууд нь  $Ca_2Si_5N_8$  болно

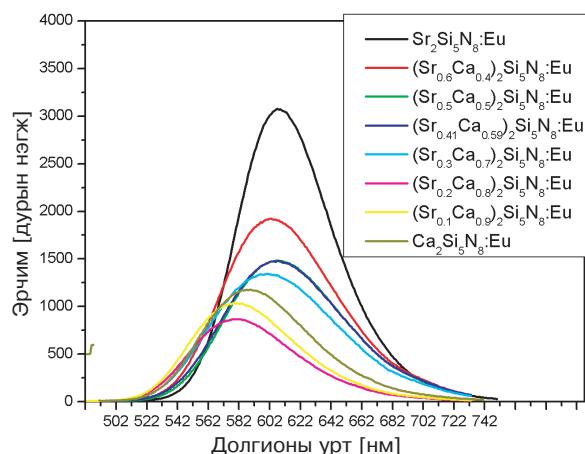
Хэмжилтийн үр дүнг  $SrSi_5N_8$ -ийн кристаллографийн өгөгдлөтэй жишиж Ритвелдийн арга ашиглан боловсруулалт хийж ( $Ca_xSr_{1-x}$ ) $Si_5N_8:Eu^{2+}$  системийн кристалл бүтэц нь орторомбик, огторгуйн групп нь  $Pmn2_1$ , эгэл торын параметрууд нь  $a=5.7069(1)\text{\AA}$ ,



Зураг 2:  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  ( $x=0.59, 0.5, 0.4, 0$ ) дээжүүдийн рентген дифракцын спектр, энд @-өөр тэмдэглэсэн пикууд нь  $\text{Sr}_2\text{Si}_5\text{N}_8$  болно

$b=6.8142(1)\text{\AA}$ ,  $c=9.3269(1)\text{\AA}$  гэж тодорхойлов. Энд  $\text{Eu}^{2+}$  ион болон Са атомууд нь  $\text{SrSi}_5\text{N}_8$  системийн Sr-ийн атомын байрлалд халж суух бөгөөд яг аль байрлалд сууж байгааг тодорхойлох боломжгүй. Эндээс үзэхэд хангалттай сайн цэвэршилт болон кристалжилттай дээжүүд гарган авч чадсан болох нь туршилтын үр дүн, бусад судлаачдын ажлаас харагдаж байна[13].

Зураг 3-т  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  ( $x=0, 0.4, 0.5, 0.59, 0.7, 0.8, 0.9, 1$ ) материалд  $\lambda=450\text{nm}$  долгионы урт бүхий цэнхэр гэрлийн өдөөлтөөр үүсэх цацааргалтын спектрийг спектрофотометр ашиглан хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнг үзүүлэв.



Зураг 3:  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  ( $x=0, 0.4, 0.5, 0.59, 0.7, 0.8, 0.9, 1$ ) материалын цэнхэр гэрлийн ( $\lambda=450\text{nm}$ ) өдөөлтөөр үүсэх цацааргалтын спектр

$(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  дээжүүдийн цацааргаж байгаа улаан-улбар шар цацааргалтын төвүүд нь  $x$ -ийн хэмжээнээс хамааран 580nm-ээс 620 nm долгионы уртын хооронд өөрчлөгдөж улаан шилжилт хийж байна. Энэ цацааргалт нь  $\text{Eu}^{2+}$  ионы  $4f^7 \rightarrow 4f^6 5d^1$  төлөвүүдийн хоорондох электроны шилжилттэй холбоотой. Энэ гэрлийн цацааргалтын максимумын шилжилт нь  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  материал дахь  $\text{Eu}^{2+}$  ионы лиганд кристалл орны салалттай холбоотой.

Са-ийн ионы радиус  $\sim 0.114\text{nm}$ , Sr-ийн ионы радиус  $\sim 0.1\text{nm}$  орчим байдаг бөгөөд  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  дээж дэх Са болон Sr-ийн хэмжээнээс хамааран торын параметр болон  $\text{Eu}^{2+}$  ионы кристалл орны харилцан үйлчлэл өөрчлөгддэг. Торын хэмжээ томрох тусам кристалл орны харилцан үйлчлэл сularч, кристалл орны салалт багасдаг бол торын хэмжээ багасах тусам кристалл орны харилцан үйлчлэл чангарч, кристалл орны салалт ихэсдэг байна. Үүнтэй холбоотойгоор  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  дээж дэх Са болон Sr-ийн концентраас хамааран цацааргалтын спектр өөрчлөгджэй байна.

#### IV. Дүгнэлт

Энэ ажлаар улаан гэрэл цацааруулагч  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  нитрид материалыг тодорхой молийн харьцаа бухий  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{Sr}_3\text{N}_2$ ,  $\text{Ca}_3\text{N}_2$  нитридууд болон  $\text{EuB}_6$  дээж ашиглан хатуу төлөвийн урвалын аргаар Са болон Sr-ийн янз бурийн концентрацтaiй байхаар өндөр цэвэршил бухий  $\text{N}_2$  хийн орчинд  $1550^\circ\text{C}$  температурт шатааж гарган авч түүний цацааргалтын шинж чанаарыг судалсан үр дүнг үзүүлэв. Рентген дифракцын хэмжилтийн үр дунгээс цэвэршил өндөртэй, кристалжилт сайтай гарган Са болон Sr-ийн янз бурийн концентрацтaiй нунтаг нитрит материал гарган авсан болох нь харагдаж байна.

Түүнчлэн  $(\text{Ca}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$  материал нь  $\lambda = 450\text{nm}$  долгионы урт бүхий цэнхэр гэрлийн өдөөлтөөр улаан-улбар шар гэрлийн мужид цацааргалт хийх бөгөөд  $x$ -ийн хэмжээнээс хамааран улаан гэрлийн долгионы урт 580-ээс 620 nm хооронд өөрчлөгджэй улаан шилжилт хийж байгааг тогтоов.

#### Талархал

Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлж "Үзэгдэх гэрлийн мужид цацааргах шинэ төрлийн лазерын материал гарган авах, түүний шинж чанаарын судалгаа" суурь судалгааны төслийг санхүүжүүлсэн ШУТС болон БСШУС -ийн яам, P2019-3738 зочин судлаачдын судалгааны тэтгэлгийг санхүүжүүлсэн МУИС, туршилтын ажлыг хамтран гүйцэтгэсэн БНХАУ-ийн ӨМӨЗО-ны Багшийн их сургуулийн Функционал материалын физик, химийн төв лабораторийн хамт олонд гүн талархал илэрхийлье.

- [1] Schubert.E.F, Kim.J.K, Solid-State Light Sources Getting Smart. *Science* 2005, 308, 1274–1278.
- [2] Pimplkar.S, Speck.J.S, DenBaars.S.P, Nakamura.S, Prospects for LED Lighting. *Nat. Photonics* 2009, 3, 180–182.
- [3] Xie.R.-J, Li.Y.Q, Yamamoto.H, Hirosaki.N, Nitride Phosphors and Solid State Lighting; CRC Press, 2011.
- [4] Lin.C.C, Liu.R.-S, Advances in Phosphors for Light-emitting Diodes. *J. Phys. Chem. Lett.* 2011, 2, 1268–1277.
- [5] Wierer.J.J, Tsao.J.Y and Sizov.D.S, *Laser Photonics Rev.*, 2013, 7, 963.
- [6] D. Chen, W. Xiang, X. Liang, J. Zhong, H. Yu, M. Ding, H. Lu and Z. Ji, *J. Eur. Ceram. Soc.*, 2015, 35, 859.
- [7] M. Raukas, J. Kelso, Y. Zheng, K. Bergenek, D. Eisert, A. Linkov and F. Jermann, *ECS J. Solid State Sci. Technol.*, 2013, 2, 3168.
- [8] Shuxing Li, Daiming Tang, Zifeng Tian, Xuejian Liu, Takashi Takeda, Naoto Hirosaki, Fangfang Xu, Zhengren Huang and Rong-Jun Xie, *J. Mater. Chem. C*, 2017, 5, 1042–1051
- [9] Н.Төвжаргал, Б.Алтантулга, Цогхүү, О.Төгс, Ж.Даваасамбуу, “ $CaAlSiN_3:xEu^{2+}$ -ийг гарган авах болон түүний гэрлийн цацаргалтын судалгаа” *Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences Vol. 57 No 03(223), x51*, 2017
- [10] Le Wang, Rong-Jun Xie, Takayuki Suehiro, et al, Down-Conversion Nitride Materials for Solid State Lighting: Recent Advances and Perspectives; *Chem. Rev.* 2018, 118, 4, 1951–2009
- [11] McKittrick.J, Shea-Rohwer.L.E, Review: Down Conversion Materials for Solid-State Lighting. *J. Am. Ceram. Soc.* 2014, 97, 1327–1352.
- [12] Hoppe.H. A, Lutz.H, Morys.P, Schnick.W, Seilmeyer.A, Luminescence in  $Eu^{2+}$ -doped  $Ba_2Si_5N_8$ : Fluorescence, Thermoluminescence and Upconversion. *J. Phys. Chem. Solids* 2000, 61, 2001–2006.
- [13] Li.Y. Q, van Steen.J.E.J, van Krevel.J.W.H, Botty.G, Delsing.A.C.A, DiSalvo.F.J, de With.G, Hintzen.H.T, Luminescence Properties of Red-Emitting  $M_2Si_5N_8:Eu^{2+}$  ( $M = Ca, Sr, Ba$ ) LED Conversion Phosphors. *J. Alloys Compd.* 2006, 417, 273–279.
- [14] Suehiro.T, Hirosaki.N, Xie.R.-J, Mitomo.M, Powder Synthesis of  $Ca\text{-}\alpha\text{-SiAlON}$  as a Host Material for Phosphors. *Chem. Mater.* 2005, 17, 308–314.
- [15] Piao.X.Q, Horikawa.T, Hanzawa.H, Machida.K, Characterization and Luminescence Properties of  $Sr_2Si_5N_8:Eu^{2+}$  Phosphor for White Light-Emitting-Diode Illumination. *Appl. Phys. Lett.* 2006, 88, 161908.
- [16] Xie.R.-J, Hirosaki.N, Suehiro.T, Xu.F.F, Mitomo.M.A, Simple, Efficient Synthetic Route to  $Sr_2Si_5N_8:Eu^{2+}$ -Based Red Phosphors for White Light-Emitting Diodes. *Chem. Mater.* 2006, 18, 5578.